

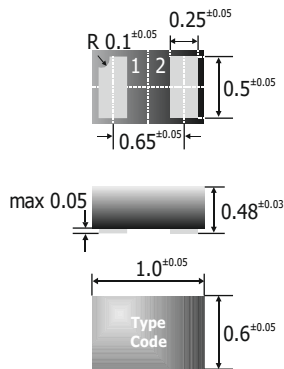
ESDBK3V3
ESD Protection Diodes in SMD
ESD-Schutzdioden in SMD

P_{PPM} = 60 W
T_{jmax} = 150°C

V_{WM} = 3.3 V
V_{BR Min} = 4 V
V_{PP} = ± 30 kV

Version 2018-07-19

SOD-882
(DFN1006-2)



Dimensions - Maße [mm]

Typical Applications

ESD protection
Data line and I/O port
protection
Commercial grade ¹⁾

Features

Low junction capacitance
Low leakage current
Miniature case outline
Compliant to RoHS, REACH,
Conflict Minerals ¹⁾

Mechanical Data ¹⁾

Taped and reeled 5000 / 7"
Weight approx. 0.0001 g
Case material UL 94V-0
Solder & assembly conditions 260°C/10s
MSL = 1

Halogen
FREE

**Typische Anwendungen**

ESD-Schutz
Schutz von Datenleitungen
und Ein-/Ausgängen
Standardausführung ¹⁾

Besonderheiten

Niedrige Sperrschicht-Kapazität
Niedriger Sperrstrom
Miniatur-Gehäusebauform
Konform zu RoHS, REACH,
Konfliktmineralien ¹⁾

Mechanische Daten ¹⁾

Gegurtet auf Rolle
Gewicht ca.
Gehäusematerial
Löt- und Einbaubedingungen

Configuration – Ausführung		Type Code
	Bidirectional – Bidirektional	J3

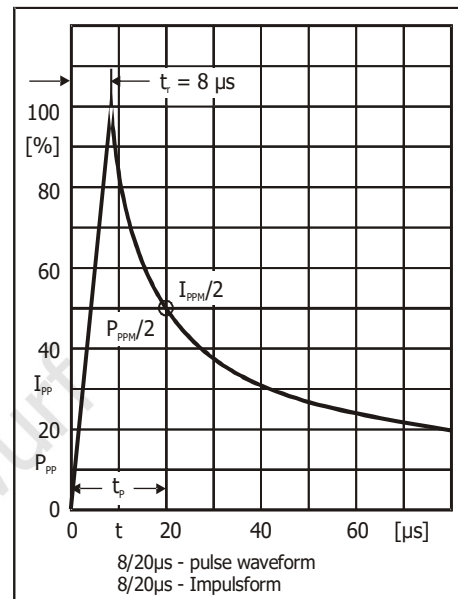
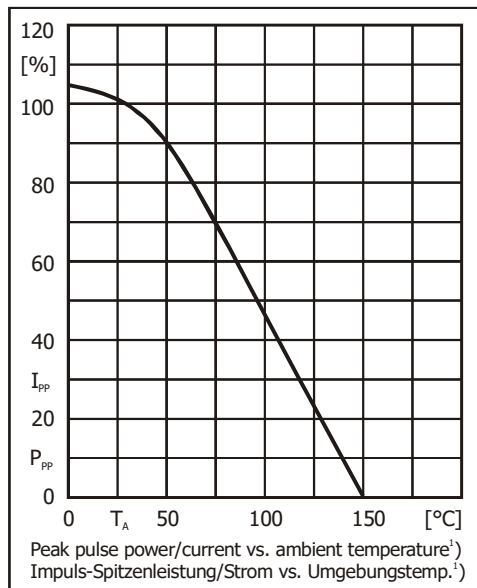
Maximum ratings ²⁾**Grenzwerte ²⁾**

Peak pulse power dissipation (8/20 µs waveform) ³⁾ Impuls-Verlustleistung (8/20 µs Impuls)	P _{PPM}	60 W
Peak pulse power current (8/20 µs waveform) ³⁾ Impuls-Strom (8/20 µs Impuls)	I _{PPM}	7 A
ESD immunity (HBM, air discharge) ESD-Festigkeit (HBM, Luftentladung) IEC 61000-4-2	V _{PP}	± 30 kV
ESD immunity (contact discharge) ESD-Festigkeit (Kontaktentladung) IEC 61000-4-2	V _{PP}	± 30 kV
Junction temperature – Sperrschichttemperatur	T _j	-50...+150°C
Storage temperature – Lagerungstemperatur	T _s	-50...+150°C

- 1 Please note the [detailed information on our website](#) or at the beginning of the data book
Bitte beachten Sie die [detaillierten Hinweise auf unserer Internetseite](#) bzw. am Anfang des Datenbuches
- 2 T_A = 25°C unless otherwise specified – T_A = 25°C wenn nicht anders angegeben
- 3 Non-repetitive pulse see curve I_{pp} = f (t) / P_{pp} = f (t)
Höchstzulässiger Spitzenwert eines einmaligen Impulses, siehe Kurve I_{pp} = f (t) / P_{pp} = f (t)

Characteristics ($T_j = 25^\circ\text{C}$)
Kennwerte ($T_j = 25^\circ\text{C}$)

Type Typ	Junction capacitance Sperrschichtkapazität $V_R = 0\text{ V}$, $f = 1\text{ MHz}$	Stand-off voltage Sperrspannung	Max. rev. current Max. Sperrstrom at / bei V_{WM}	Breakdown voltage Abbruch-Spannung $I_T = 1\text{ mA}$	Max. clamping voltage Max. Begrenzer-Spannung at / bei I_{PPM} (8/20 μs)	
	C_j [pF]	V_{WM} [V]	I_D [μA]	V_{BR} [V]	V_C [V]	I_{PPM} [A]
ESDBK3V3	typ. 15	3.3	0.4	4 ... 6	9	7



Disclaimer: See data book page 2 or [website](#)
Haftungsschluss: Siehe Datenbuch Seite 2 oder [Internet](#)

1 Mounted on P.C. board with 3 mm² copper pads at each terminal
Montage auf Leiterplatte mit 3 mm² Kupferbelag (Lötpad) an jedem Anschluss